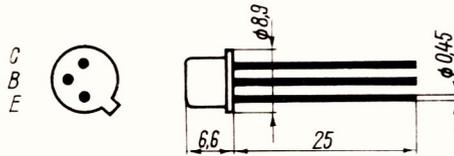


Mittelschneller Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Schalttransistor der Bauform B 3/25 - 3a nach TGL 11 811, Kollektor am Gehäuse, für die Verwendung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen

[www.datasheetcatalog.com](http://www.datasheetcatalog.com)



Masse ca. 1 g

**Grenzwerte gültig bis  $\vartheta_{aL}$**

Kollektor-Basis-Spannung	$U_{CBO}$	= 30 V
Kollektor-Emitter-Spannung	$U_{CEO}$	= 25 V
Emitter-Basis-Spannung	$U_{EBO}$	= 5 V
Kollektorstrom bei $t_{av} = 20$ ms	$I_{CL}$	= 500 mA
Kollektorspitzenstrom	$\hat{I}_{CL}$	= 700 mA
Basisstrom	$I_{BL}$	= 250 mA
Gesamtverlustleistung bei $\vartheta_a = 25$ °C	$P_{VL}$	= 600 mW
Gesamtverlustleistung bei $\vartheta_c = 25$ °C	$P_{VL}$	= 2,5 W
Sperrschichttemperatur	$\vartheta_{jL}$	= +175 °C
Umgebungstemperatur	$\vartheta_{aL}$	= -40 °C bis +125 °C
Wärmewiderstand	$R_{thja}$	≤ 250 grd/W
Wärmewiderstand	$R_{thjc}$	≤ 60 grd/W

Statische Kennwerte		Min.	Typ	Max.		
Kollektor-Basis-Reststrom	$I_{CBO}$			25 nA		
$U_{CB} = 20 \text{ V}$						
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung	$U_{(BR)CEO}$	25 V				
$I_C = 50 \text{ mA}$						
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$U_{BEsat}$			1 V		
$I_B = 40 \text{ mA}$						
$I_C = 400 \text{ mA}$						
<b>Dynamische Kennwerte</b>					Stromverstärkungsgruppe	
Kurzschlußstromverstärkung	$h_{21E}$	18		35		A
$U_{CE} = 1 \text{ V}$		28		71		B
$I_C = 400 \text{ mA}$		56		140		C
Messung erfolgt impulsmäßig						
Übergangsfrequenz	$f_T$	30 MHz				
$U_{CE} = 12 \text{ V}$						
$I_C = 50 \text{ mA}$						
$f = 15 \text{ MHz}$						

[www.datasheetcatalog.com](http://www.datasheetcatalog.com)

Bestellbeispiel für einen Transistor  
der Stromverstärkungsgruppe C

Transistor SS 125 C

